## Влияние размера кристаллита на коэффициенты распыления и отражения

А.В. Смаев, В.С. Михайлов, А.Н. Зиновьев nstitute

loffe

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия e-mail: alexander.smaev@icloud.com

53-я Международная Тулиновская конференция по Физике Взаимодействия Заряженных Частиц с Кристаллами

Москва, МГУ им М.В. Ломоносова, 28 мая – 30 мая 2024



## Аннотация

С помощью разработанного нами кода впервые получены коэффициенты распыления Y и отражения Rn вольфрамовой мишени аргоном в диапазоне энергий бомбардирующих частиц 0.01-100 keV в зависимости от размера кристаллита, выраженного в числе элементарных ячеек N, и типа поверхностного потенциального барьера. При энергиях свыше 100 eV с ростом размера зерна наблюдается существенный рост коэффициента распыления. Зависимость коэффициента отражения наблюдается в широком диапазоне N. Обнаружено сильное влияние выбора типа поверхностного барьера на результаты расчетов коэффициентов распыления. Полученные результаты необходимы для анализа поступления примеси вольфрама в горячую зону плазмы токамака.



Рис. 1. Зависимость коэффициента распыления от энергии соударения при нормальном падении пучка на мишень. Наш расчет для сферического барьера — штриховые цветные линии, сплошные цветные линии — расчет для планарного барьера. Цифрами у кривых показан размер кристаллита N. Точки — экспериментальные данные [1]. Серая штрихпунктирная линия — расчет группы Экштайна [1, 2].

Рис. 2. Зависимость коэффициента отражения от энергии соударения при нормальном падении пучка на мишень. Штриховые цветные линии — наш расчет. Цифрами у кривых показан размер кристаллита N. Черная линия — расчет программой SDTrimSP из работы Экштайна [3]. Квадраты — расчет программой АСАТ [4]. Звезда — расчет программой MARLOWE [5]



Для наглядности тепловые колебания отключены. Цветные точки — на каком атоме кластера происходит парное упругое столкновение. Кластеры в одном и том же зерне окрашены в единый цвет. Черная линия — траектория налетающего Ar. Во время моделирования происходило усечение всех атомов левее серой плоскости (с координатами Z < 0)

Мишень представляла из себя последовательную очередность кластеров атомов размером в одну постоянную решетки. Положение первого кластера и его ориентация в пространстве выбирались случайным образом.

После акта соударения строился следующий кластер, центр которого соответствовал положению атома, на котором произошло дальнейшее рассеяние. В случае N = 1 ориентация этого кластера в пространстве менялась случайным образом каждый раз при построении. В случае  $N \ge 2$  пространственная ориентация кластера сохранялась для N актов соударения. Затем ориентация кластера вновь выбирались случайным образом и вновь сохранялась в течение *N* соударений. Тем самым моделировалась поликристаллическая мишень с размером зерна кристаллита *N*, выраженным в числе элементарных ячеек.

## выводы

- Показано, что при увеличении числа *N* коэффициенты распыления в случае Ar-W растут в обоих случаях потенциального барьера вплоть до N = 8. При энергиях свыше 100 eV с ростом размера зерна кристаллита наблюдается существенное увеличение коэффициента распыления. При дальнейшем росте размера кристаллита N > 8 зависимость Y стремится к насыщению. Предполагается, что полученные зависимости коэффициентов распыления от размера кристаллита в мишени связаны с проявлениями эффекта каналирования при выходе частиц отдачи из мишени.
- Продемонстрировано влияние выбора типа поверхностного барьера на результаты расчетов коэффициентов Ү. Экспериментальные данные лучше согласуются с результатами моделирования плоскостного барьера.
- Обнаружено, что коэффициент отражения также зависит от размера кристаллита. Эта зависимость наблюдается вплоть до режима N = 100, затем исчезает.

1. R. Behrisch, W. Eckstein. Sputtering by Particle Bombardment (Springer, Berlin, 2007). DOI: 10.1007/978-3-540-44502-9

2. R.E.H. Clark, Atomic and Plasma-Material Interaction Data for Fusion. v.7, Part B (IAEA, Vienna, 2001).

3. W. Eckstein. Reflection (Backscattering). IPP-17-12 (IPP, Garching, 2009).

**4.** Y. Yamamura. NIMB, 33(1-4), 429 (1988). DOI: 10.1016/0168-583X(88)90599-X

5. O.S. Oen, M.T. Robinson. AIP Conf. Proc., 111(1), 171 (1984). DOI: 10.1063/1.34417

6. В.С. Михайлов, П.Ю. Бабенко, А.П. Шергин, А.Н. Зиновьев, ЖЭТФ, 164 (3), 478 (2023). DOI: 10.31857/S004445102309016X